

CBCP68 NPN
CBCP69 PNP

SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY
SMALL SIGNAL SILICON
TRANSISTORS



SOT-223 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBCP68 and CBCP69 types are complementary silicon transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for applications requiring high current capability.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Collector-Emitter Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Peak Collector Current
Continuous Base Current
Peak Base Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{CES} 25
 V_{CEO} 20
 V_{EBO} 5.0
 I_C 1.0
 I_{CM} 2.0
 I_B 100
 I_{BM} 200
 P_D 2.0
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 62.5

UNITS

V
V
V
A
A
mA
mA
W
 $^{\circ}\text{C}$
 $^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}$			10	μA
I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, T_A=150^{\circ}\text{C}$			1.0	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$			10	μA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	25			V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	20			V
BV_{EBO}	$I_E=1.0\mu\text{A}$	5.0			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}, I_B=100\text{mA}$			0.5	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5.0\text{mA}$		0.6		V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$			1.0	V
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5.0\text{mA}$	50			
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$	85		375	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$	60			
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=20\text{MHz}$	65			MHz
C_{ob}	$V_{CB}=5.0\text{V}, I_E=0, f=450\text{kHz}$		25		pF

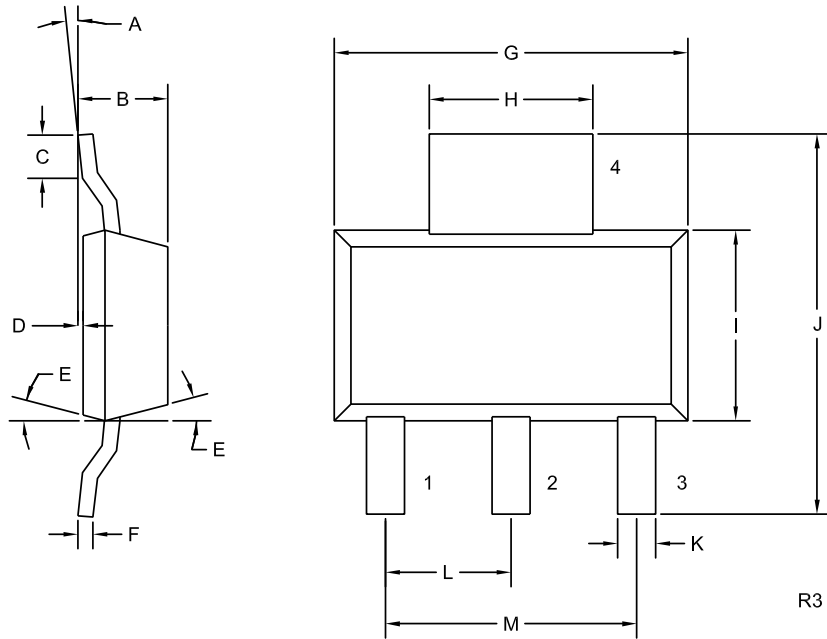
R5 (4-January 2010)

CBCP68 NPN
CBCP69 PNP

SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY
SMALL SIGNAL SILICON
TRANSISTORS



SOT-223 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) BASE
- 2) COLLECTOR
- 3) EMITTER
- 4) COLLECTOR

MARKING:

FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0°	10°	0°	10°
B	0.059	0.071	1.50	1.80
C	0.018	---	0.45	---
D	0.000	0.004	0.00	0.10
E	15°		15°	
F	0.009	0.014	0.23	0.35
G	0.248	0.264	6.30	6.70
H	0.114	0.122	2.90	3.10
I	0.130	0.146	3.30	3.70
J	0.264	0.287	6.70	7.30
K	0.024	0.033	0.60	0.85
L	0.091		2.30	
M	0.181		4.60	

SOT-223 (REV: R3)

R5 (4-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9